

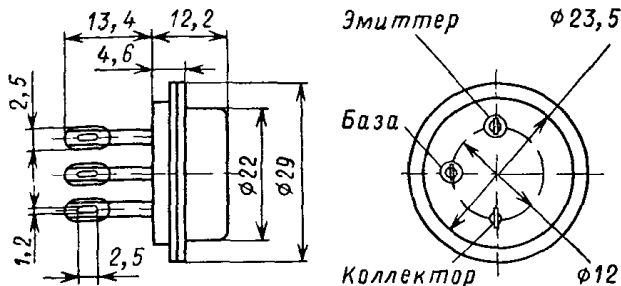
2Т808А, КТ808А

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* переключаемые
низкочастотные мощные

Предназначены для работы в ключевых схемах, генераторах
строчной развертки, электронных регуляторах напряжения

Выпускаются в металlostеклянном корпусе с жесткими выводами.
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 22 г, накидного фланца 12 г



Электрические параметры

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 6$ А, $I_B = 0.6$ А	$1^* - 2.5$ В
типовое значение	1.4^* В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KЭ} = 3$ В, $I_K = 6$ А	
при $T = 298$ К	10–50
типовое значение	15^*
при $T = 398$ К 2Т808А и $T = 373$ К КТ808А	10–150
при $T = 213$ К	6–50
Отношение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $T = 398$ К к стати- ческому коэффициенту при $T = 298$ К не более	3
Время рассасывания при $U_{KЭ} = 15$ В, $I_K = 6$ А не более	2 мкс
Модуль коэффициента передачи тока при $f = 3.5$ МГц, $U_{KЭ} = 10$ В, $I_Э = 0.5$ А не менее	2,4
Емкость коллекторного перехода при $U_{KЭ} = 10$ В, $f = 1$ МГц не более	500 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом при $T = 298$ и 213 К, $U_{KЭ} = 200$ В 2Т808А и $U_{KЭ} = 120$ В КТ808А не более	3 мА
типовое значение	$0,1^*$ мА
при $T = 398$ К, $U_{KЭ} = 160$ В 2Т808А не более	20 мА
при $T = 373$ К, $U_{KЭ} = 120$ В КТ808А не более	20 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В не более	50 мА
типовое значение	4^* мА

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$, $T_{п} \leq 373 \text{ К}$	120 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 2 \text{ В}$ и ли $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$, $\tau_{п} \leq 500 \text{ мкс}$, $Q \geq 6$, $T_{п} \leq 373 \text{ К}$	250 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при $T = 213 - 398 \text{ К}$	4 В
Постоянный ток коллектора при $T = 213 - 398 \text{ К}$	10 А
Ток базы при $T = 213 - 398 \text{ К}$	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{к} = 213 - 323 \text{ К}$ с теплоотводом	50 Вт
при $T = 213 - 323 \text{ К}$ без теплоотвода	5 Вт
Тепловое сопротивление переход корпус	2 К/Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	
2Т808А	От $T_{к} = 213$ до $T_{к} = 398 \text{ К}$
КТ808А	От $T = 213 \text{ К}$ до $T_{к} = 373 \text{ К}$

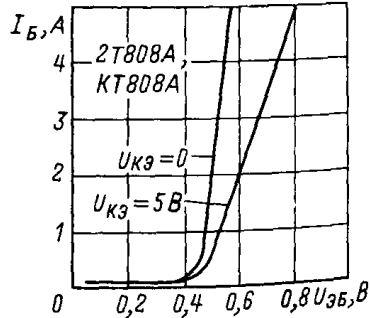
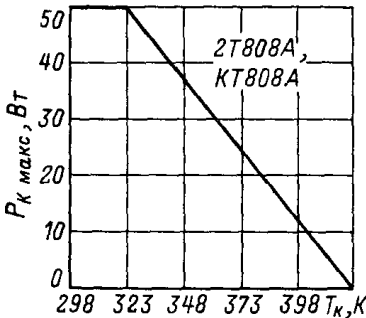
Примечания 1 Постоянное и импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $T_{п} = 373 - 423 \text{ К}$ снижается линейно на 10% через каждые 10 К

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне температур

Для снижения контактного теплового сопротивления между корпусом и теплоотводом необходимо применять смазку из невысыхающего масла или тонкую фольгу из мягкого металла

2 Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать $19,62 \text{ Н}$ в осевом и $3,43 \text{ Н}$ в перпендикулярном направлениях к оси вывода

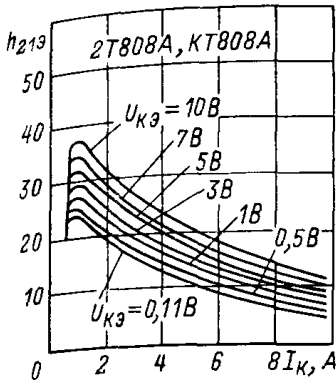
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора



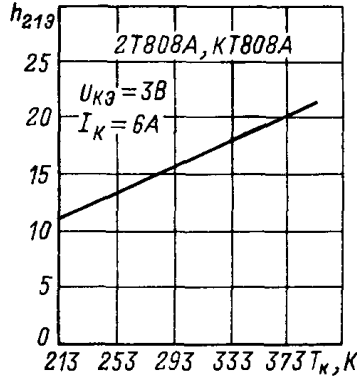
Зависимость максимально допустимой рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

Входные характеристики

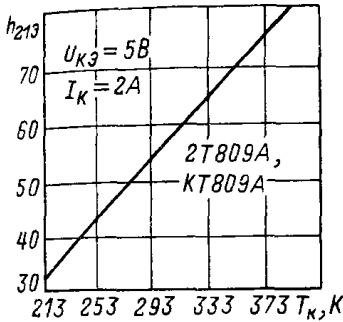
Материал взят из источника:



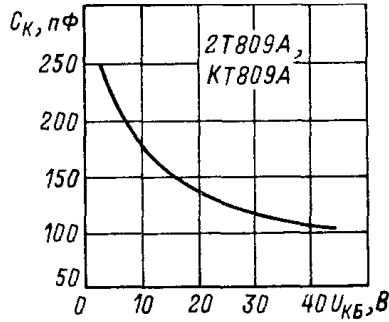
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



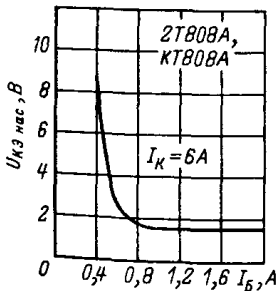
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



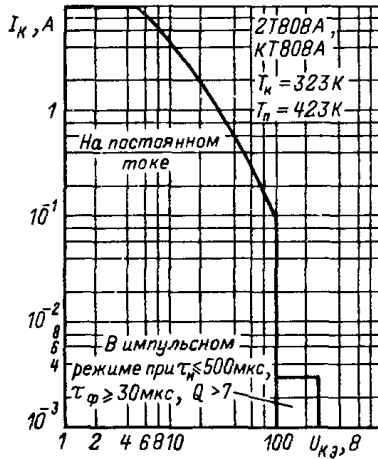
Зависимость статического коэффициента передачи тока корпуса



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



Область максимальных режимов

Материал взят из источника: